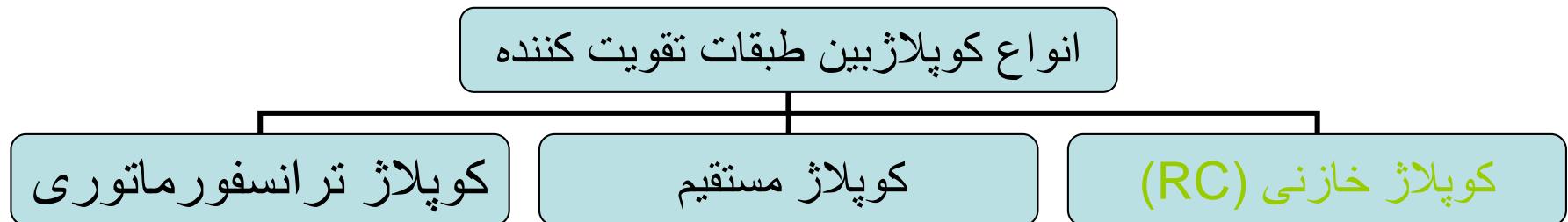
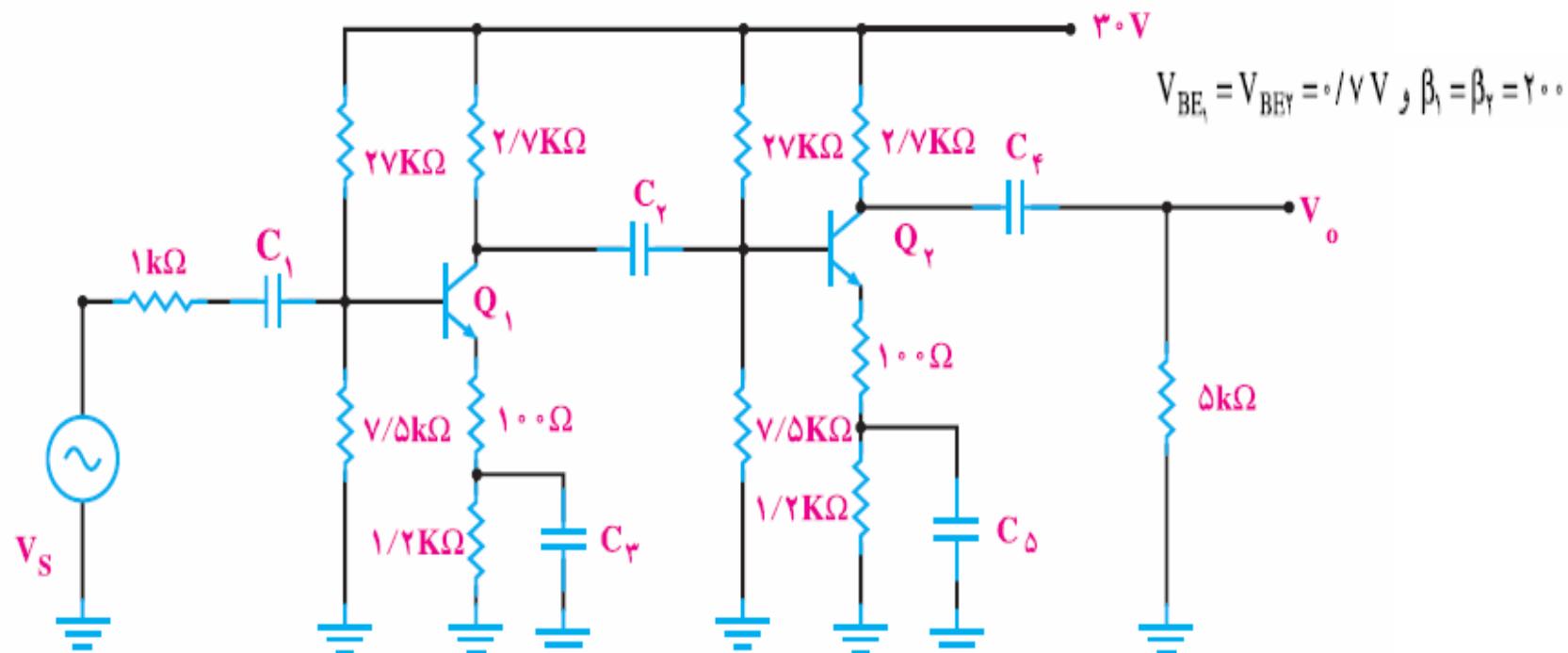


کوپلاژ : عمل اتصال بین طبقات تقویت کننده چند طبقه را گویند



- **کوپلاز خازنی**: در این حالت اتصال بین طبقات توسط خازن صورت می گیرد. چون خازن همراه مقاومت بکار گرفته می شود کوپلاز RC گویند.
- **کوپلاز مستقیم**: ارتباط بین طبقات توسط هادی صورت می گیرد.
- **کوپلاز ترانسی**: ارتباط بین طبقات توسط ترانسهاای دوسیم پیچ مجزا صورت می گیرد.

- شکل زیر یک تقویت کننده دو طبقه رانشان می دهد که توسط کوپلاژ خازنی به هم ارتباط دارند.
- خازن مانع عبور ولتاژ DC از یک طبقه به طبقه دیگر خواهد شد. در نتیجه نقطه کار ترانزیستورها مستقل از یکدیگر نباید بطور جداگانه حساب نمود.
- **تمرین**: در شکل زیر نوع بایاس و آرایش ترانزیستورها را پیدا کنید؟ مشخصات نقطه کار هر کدام را بدست آورید؟
- **تمرین**: ظرفیت خازنهای کوپلاژ چگونه محاسبه می شوند؟



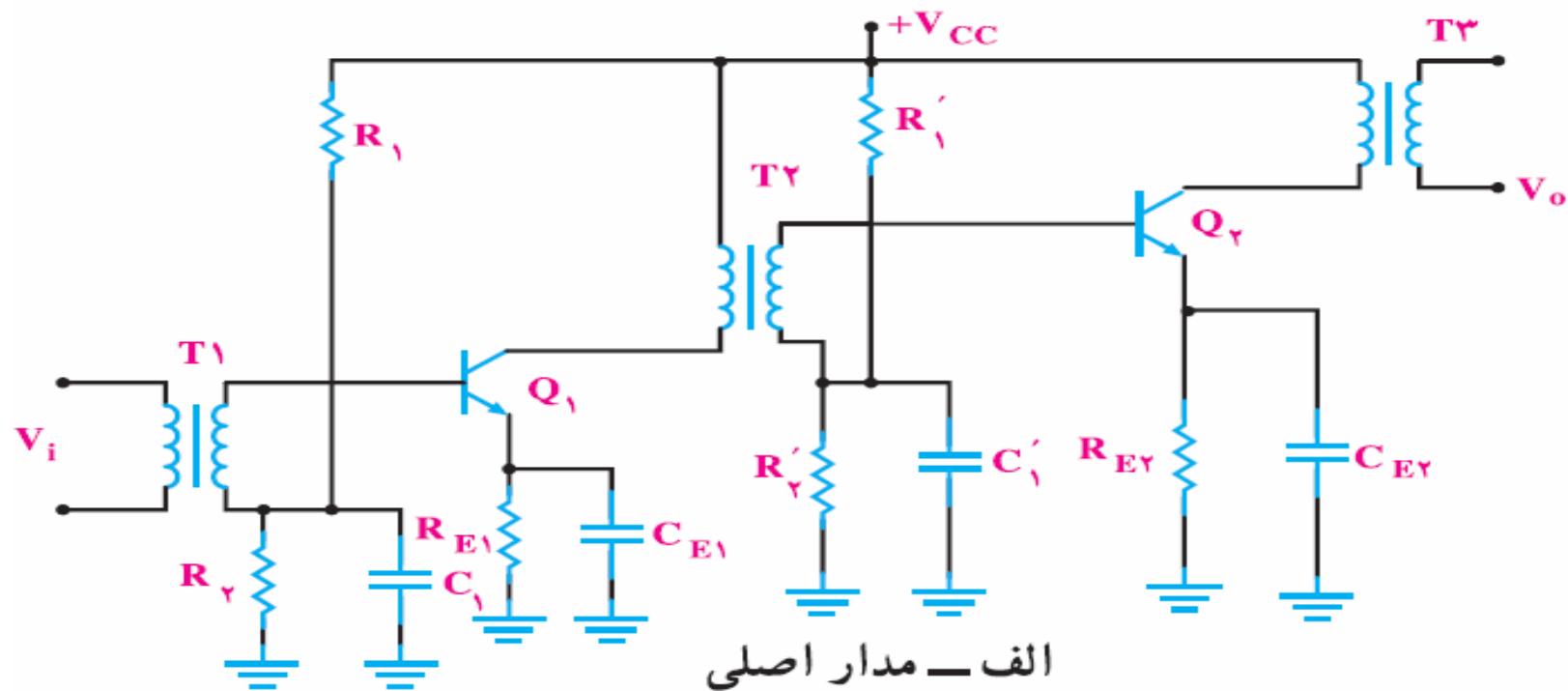
عیوب کوپلاژ خازنی

- در فرکانس‌های کار کم، راکتانس خازنی زیاد بوده و افت شدیدی در سیگنال ایجاد می‌شود.
- بعلت استفاده زیاد از مقاومتها تلفات در مدار زیاد است.

این نوع کوپلاژ
در تقویت کننده‌های قدرت کم
استفاده می‌شود.

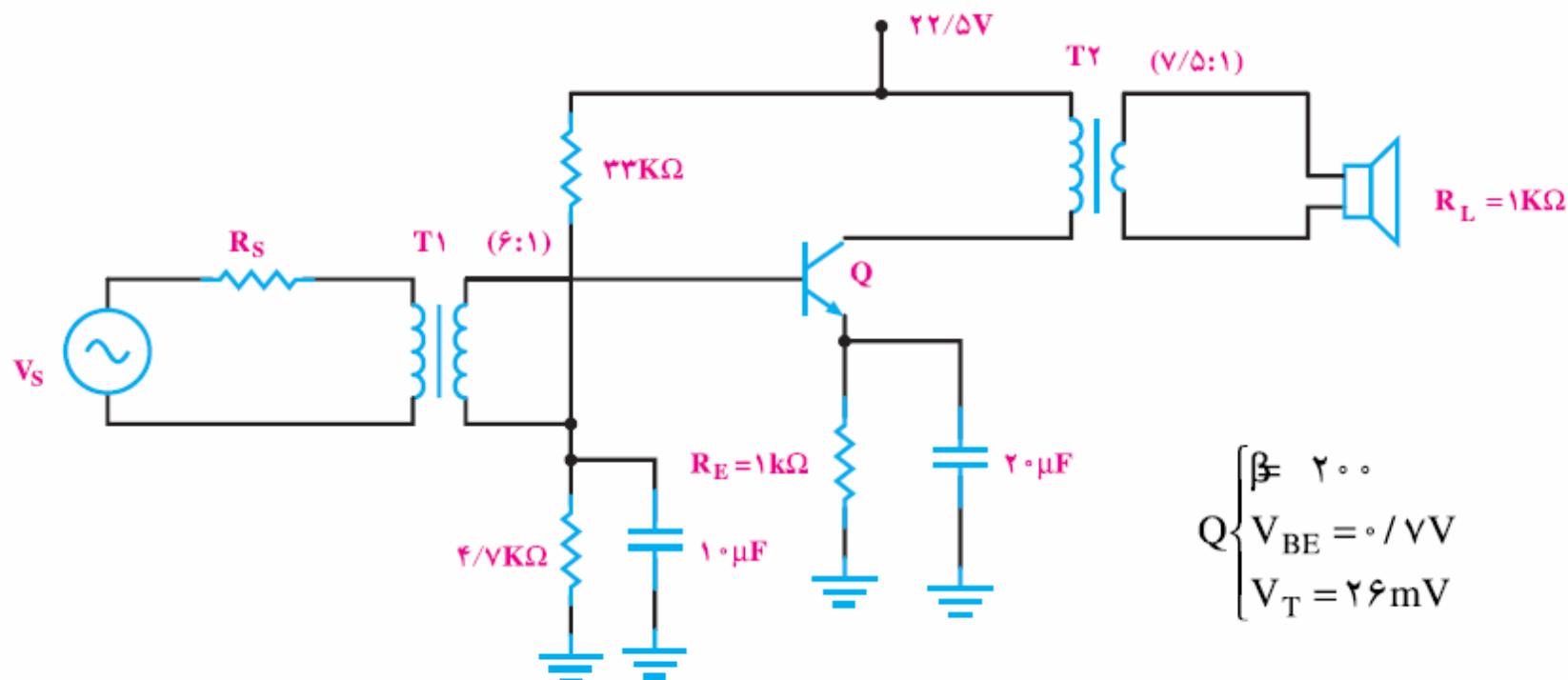
- جهت برطرف کردن عیبهای کوپلاز RC از ترانسفورماتور استفاده می شود.
- در اینگونه مدارات نیز نقاط کار ترانزیستورها مستقل از یکدیگرند.

عيوب اين نوع كوپلاز: حجم زياد مدار و بزرگ شدن كيت الكترونiki-افزايش قيمت مدار بخاطر وجود ترانس -پاسخ بد فركانسي مدار در فركانسيهاي پائين



مثال ۴: در شکل ۴-۹ اگر ترانسفورماتورها ایده‌آل فرض شوند، اولاً جریان نقطه‌ی کار ترانزیستور را محاسبه کنید.

ثانیاً برای انتقال حداکثر توان از منبع V_S به بار R_L امپدانس اولیه‌ی ترانسفورماتورهای T_1 و T_2 را به دست آورید.



$$Q \begin{cases} \beta = 200 \\ V_{BE} = 0.7\text{V} \\ V_T = 26\text{mV} \end{cases}$$

شکل ۴-۹

راه حل:

$$V_B = 22 / 5 \times \frac{4 / V}{4 / V + 22} = 2 / 8 V$$

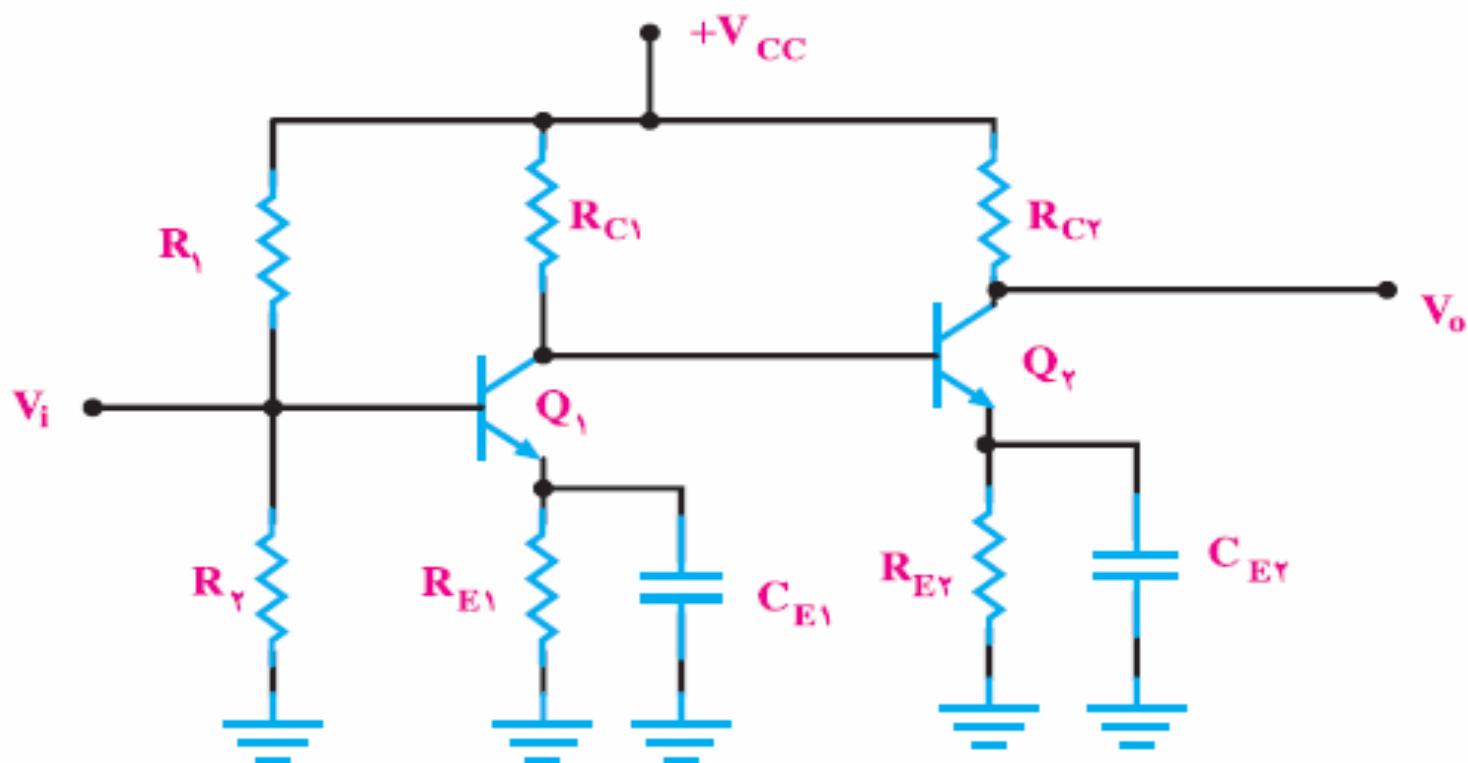
$$V_E = V_B - V_{BE} = 2 / 8 - 0.1 / V = 2 / 9 V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2 / 9}{1} = 2 / 9 mA \Rightarrow I_C \approx I_E = 2 / 9 mA$$

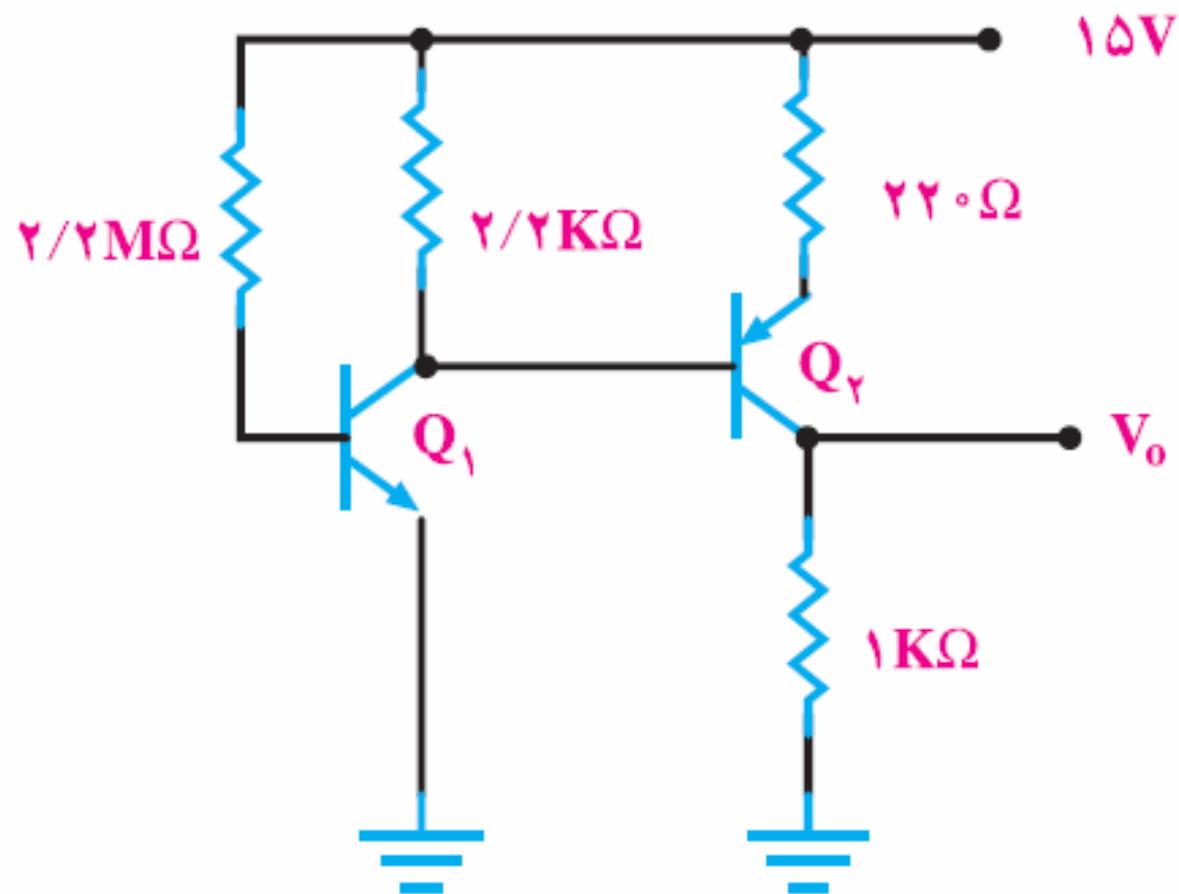
$$T_{\text{trans}} \begin{cases} Z_S = R_L = 1k\Omega \\ Z_P = Z_S \times (V / \beta)^\gamma = 1 \times (V / \beta)^\gamma = 56 / 25 k\Omega \end{cases}$$

$$T_{\text{trans}} \begin{cases} Z_S = r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 30 \quad \frac{22}{I_C} = 20 \times \frac{22}{2 / 9} = 2 / 5 k\Omega \\ Z_P = 2 / 5 \times (2)^{\gamma} = 40 k\Omega \end{cases}$$

- شکل زیر یک تقویت کننده دو طبقه با کوپلاژ مستقیم است.
- اتصال مستقیم بین طبقات (بدون هیچ واسطه) وجود دارد.
- نقاط کار ترانزیستورها به هم وابسته است. باید جهت تعیین مشخصات نقطه کار ترانزیستورها معادلات را با هم وبطور ادغامی نوشت.



مثال ۵: در شکل ۱۱-۴ با فرض $\beta_1 = \beta_2 = ۲۰۰$ و $|V_{BE}| = ۰.۶\text{V}$ ، مقدار ولتاژ V_o چه قدر است؟



راه حل: روش تقریبی

$$I_{B1} = \frac{15 - 0.6}{2/2} = 6 / 0.54 \mu A$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 6 / 0.54 \times 200 = 1 / 3 mA$$

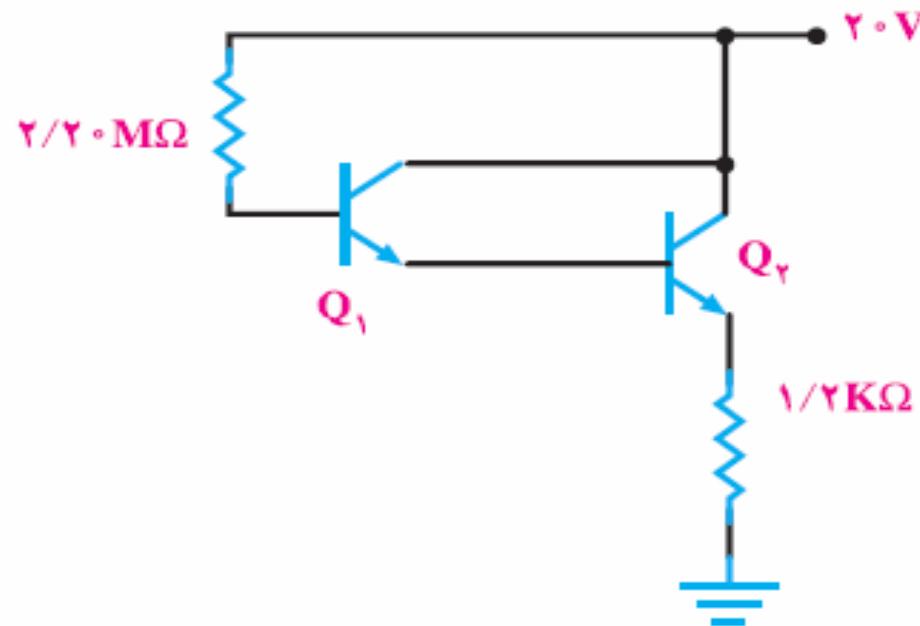
$$2/2 \times 1/3 = 0.6 + 0.22 I_{C2} \Rightarrow I_{C2} = 10 / 27 mA$$

$$V_o = 10 / 27 \times 1 = 10 / 27 \text{ Volt}$$

• راه حل به روش دقیق:

تمرین:

با فرض $V_{BE_1} = V_{BE_2} = 0.7V$ و $\beta_1 = \beta_2 = 50$ تلف چه قدرتی در ترانزیستور Q_2 می شود.



$$V_{C_1} = V_{B_1} - \eta / V = 8 - \eta / V = V / 3$$

$$V_{C_1} = 12 - 2 / 2 \times 1 / 65 = 8 / 37 V$$

$$V_{E_1} = 4 - \eta / V = 3 / 3 V$$

$$V_{CE_1} = V / 3 - 3 / 3 = 4 V$$

$$V_{CE_1} = 8 / 37 V - V / 3 = 1 / 3 V$$

$$P_{Q_1} = V_{CE_1} \times I_{C_1} = 4 \times 1 / 65 = 6 / 6 mW$$

$$P_{Q_1} = V_{CE_1} \times I_{C_1} = 1 / 3 V \times 1 / 65 = 1 / 1950 mW$$

مثال ۷: در شکل ۱۹-۴ با فرض $\beta_1 = \beta_2 = 120$ و

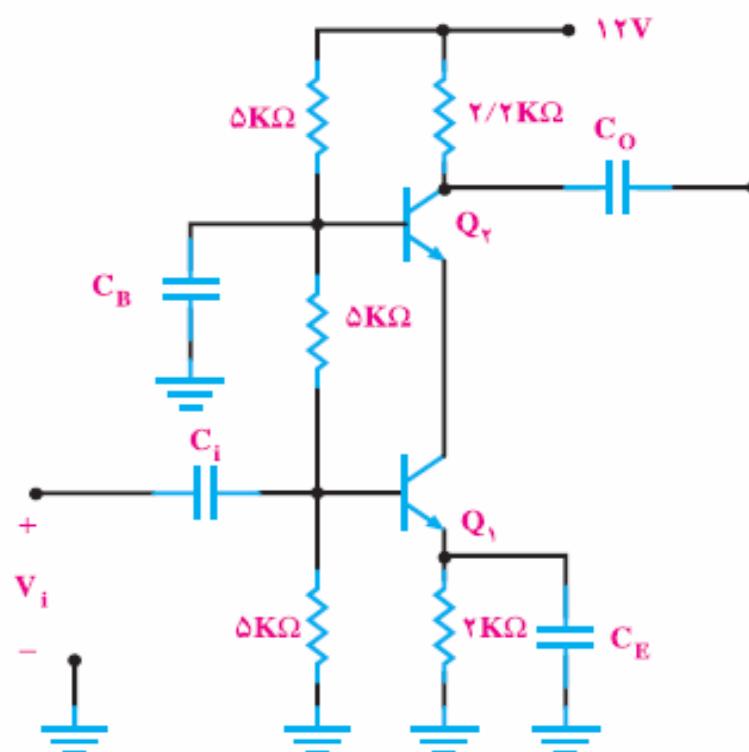
قدرت تلف شده در هر ترانزیستور را

محاسبه کنید.

راه حل:

$$V_{B_1} = \frac{\Delta}{\Delta + 1} \times 12 = 4 V \Rightarrow V_{B_1} = 2 \times 4 = 8 V$$

$$I_{E_1} = I_{E_2} = I_{C_1} = I_{C_2} = \frac{V_{B_1} - \eta / V}{2} = \frac{4 - \eta / V}{2} = 1 / 65 mA$$



This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.